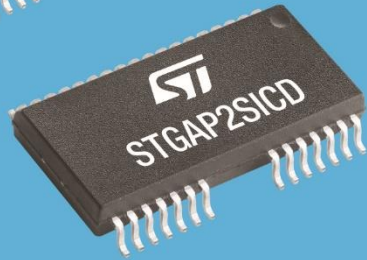
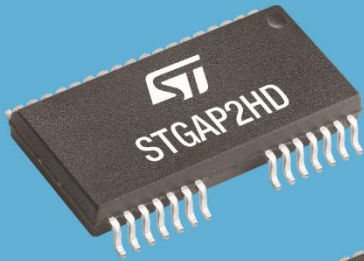




life.augmented

新聞稿



Galvanically-isolated dual gate drivers for IGBTs and SiC MOSFETs



意法半導體雙通道閘極驅動器優化並簡化SiC和IGBT開關電路

【台北訊，2022年2月18日】— 服務橫跨多重電子應用領域的全球半導體領導商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）新推出兩款雙通道電氣隔離IGBT和碳化矽（SiC）MOSFET閘極驅動器，能在高壓電力轉換和工業應用中節省空間，簡化電路設計。

IGBT驅動器STGAP2HD和SiC MOSFET驅動器STGAP2SICD利用意法半導體最新的電氣隔離技術，並採用SO-36W寬體封裝，可承受6kV瞬態電壓。此外， $\pm 100\text{V/ns}$ dv/dt 瞬態耐量可防止在高電噪聲運作環境下產生雜散導通現象。這兩款驅動器皆提供最高4A的閘極控制訊號，雙輸出腳位為閘極驅動帶來更多靈活性，支援導通和關斷時間個別調整。主動米勒鉗制功能可防止閘極在半橋拓撲快速換向過程中出現尖峰電壓。

電路保護功能包括過熱保護、看門狗安全操作機制，每個通道都有欠壓鎖定（Under-Voltage Lockout，UVLO）機制，防止驅動器在危險的低效模式下啟動。依照SiC MOSFET的技術要求，STGAP2SICD提高了UVLO的閾值電壓，以優化電晶體的效能。

每款元件都有一個在雙低邊不對稱半橋應用中同時開通兩個通道的iLOCK腳位，以及防止在傳統半橋電路中出現直通電流的互鎖保護機制。這兩款驅動器在高壓軌上的額定電壓皆高達1200V，輸入至輸出傳播時間為75ns，PWM控制精度很高。

意法半導體新推出之雙通道電氣隔離閘極驅動器具有專用的關斷腳位、制動腳位以及省電待機腳位，主要

應用包含電源、驅動器、逆變器、焊接機和充電器。此外，輸入腳位可與最低3.3V的TTL和CMOS邏輯訊號相容，以簡化驅動器與主微控制器或DSP處理器的連接。

STGAP2HD和STGAP2SICD現已量產。[EVALSTGAP2HDM](#)和[EVALSTGAP2SICD](#)展示板也已上市，用於快速評估驅動器在驅動半橋功率級時的驅動特性。

更多資訊，請造訪：www.st.com/stdrive。

關於意法半導體

意法半導體 (STMicroelectronics ; ST) 擁有46,000名半導體技術、產品和方案的創新和創造者，掌握半導體供應鏈和最先進的製造設備。作為一家獨立的半導體設備製造商，意法半導體與逾十萬客戶、上千合作夥伴一起研發產品和解決方案，共同打造生態系統，一同攜手應對各種挑戰和機會，滿足世界對於可持續發展之更高的需求。意法半導體的技術讓人們出行更智能、電力和能源管理更高效、物聯網和5G技術應用更廣泛。詳情請瀏覽意法半導體公司網站：www.st.com。